



제 31회 한국반도체학술대회

The 31st Korean Conference on Semiconductors

2024년 1월 24일(수)-26일(금) | 경주화백컨벤션센터(HICO)

2024년 1월 26일(금), 13:45-15:30

Room A(101), 1층

B. Patterning (Lithography & Etch Technology) 분과

[FA2-B] Lithography and photoresist II

좌장: 이상설 박사(POSTECH), 김진곤 박사(SKMP)

초청발표 FA2-B-1 13:45-14:15	Hybrid Multilayer EUV Dry Photoresist for 1.5 nm Technology Node Myung Mo Sung Hanyang University
FA2-B-2 14:15-14:30	Single EUV Patterning Margin Improvement Minkwon Choi, Hyejun Jin, Jeonghoon Ahn, and Jongho Lee Foundry Business, Samsung Electronics Co., Ltd.
FA2-B-3 14:30-14:45	EUV 펄리클의 Emissivity 에 대한 다층 Emission 구조의 영향 연구 강영우 ^{1,2} , 김하늘 ^{1,2} , 김원진 ^{1,2} , 김정연 ^{1,2} , 박영욱 ^{1,2} , 안진호 ^{1,2} ¹ 한양대학교 신소재공학과, ² EUV-IUCC
FA2-B-4 14:45-15:00	Fizeau Interferometry 를 이용한 EUV Attenuated Phase Shift Mask 평 가 기술 연구 이동기 ^{1,3} , 문승찬 ^{2,3} , 홍준호 ^{1,3} , 안진호 ^{1,2,3} ¹ 한양대학교 신소재공학과, ² 한양대학교 나노반도체공학과, ³ EUV-IUCC
초청발표 FA2-B-5 15:00-15:30	불소화 주석산화물 극자외선 레지스트 개발 이진균 ¹ , 구예진 ¹ , 안형주 ¹ , 김지호 ² , 이상설 ² , 이서현 ³ , 정병준 ³ , 고차원 ⁴ , 니시츠네히로 ⁴ , 김현우 ⁴ ¹ 인하대학교 고분자공학과, ² 포항공대 가속기연구소, ³ 서울시립대학교 신소재공학과, ⁴ Samsung Electronics Co., Ltd.